

[首页](#)[学院概况](#)[科学研究与服务](#)[本科生教育](#)[研究生教育](#)[党群工作](#)[团学工作](#)[社会资源](#)[师资队伍](#)[副教授](#)[首页 > 学院概况 > 师资队伍 > 副教授](#)[教授](#)[副教授](#)[讲师](#)**杨国锋**

性别: 男

出生年月: 1985.06

职称、职务: 副教授

电话(手机): 18115396518

E-mail: gfyang@jiangnan.edu.cn

**【学术简介】**

博士, 副教授, 硕导。江南大学理学院光电信息科学与工程系教师, 南京大学电子科学与工程学院博士后。美国光学学会、中国光学学会和江苏省光学学会会员。长期从事III-V族宽禁带半导体和二维半导体材料和光电器件及传感系统的研究工作, 已在国际SCI学术刊物上发表学术论文80余篇。申请发明专利10项, 授权1项。主持国家自然科学基金2项, 江苏省自然科学基金青年基金1项, 主持中国博士后和江苏省博士后基金3项, 无锡市科技发展基金2项, 主持中央高校基本科研业务费重点专项项目2项, 企业横向项目6项, 累计主持科研经费300余万元。参与完成国家973、863、自然科学基金和江苏省自然科学基金等多项重点项目课题。获中国轻工业联合会和中国商业联合会科技进步奖各1项, 获2016年“中国光学重要进展”和“江苏青年光学科技奖”。

**【工作及研究经历】**

2013.06-至今, 江南大学理学院光电信息科学与工程系副教授;

2008.09-2013.06, 南京大学电子科学与工程学院, 微电子学与固体电子学工学博士学位;

2004.09-2008.06 南京航空航天大学, 应用化学学士。

**【研究领域】**

III-V族半导体材料和二维材料生长, 半导体光电和电子器件设计, 半导体光电器件制备, 半导体光电探测和传感系统设计。

**【主要代表性论文】**

[1] Jin Wang, Yang Guofeng\*, Rui Sun, *et al.*, A study on the electronic and interfacial structures of monolayer ReS<sub>2</sub>-metal contacts, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2017, 19, 27052-27052.

[2] ChuJun Yao, Yang Guofeng\*, Rui Sun, *et al.*, High-performance AlGaN-based solar-blind avalanche photodiodes with dual-periodic III-nitride distributed Bragg reflectors, *Applied Physics Express*, 2017, 10, 034302.

[3] Yang Guofeng\*, Qing Zhang, Jin Wang, *et al.*, InGaN/GaN multiple quantum wells on selectively grown GaN microfacets and the applications for phosphor-free

white light-emitting diodes, *Review in Physics*, 2016, 1, 101-119.

[4] Yang Guofeng\*, Chen Peng, Shumei Gao, *et al.*, White-light emission from InGaN/GaN quantum well microrings grown by selective area epitaxy, *Photonics Research*, 2016, 4, 17-20.

[5] Yang Guofeng\*, Qing Zhang, Jin Wang, *et al.*, Analysis of 270/290/330-nm AlGaIn-based deep ultraviolet light-emitting diodes with different Al content in quantum wells and barriers, *IEEE Photonics Journal*, 2015, 7, 2200707.

[6] Yan Dawei, Ren Jian, Yang Guofeng, *et al.*, Surface acceptor-like trap model for gate leakage current degradation in lattice-matched InAlN/GaN HEMTs, *IEEE Electron Device Letters*, 2015, 36, 1281-1283.

[7] Yang Guofeng\*, Xie Feng, Chen Peng, *et al.*, Formation of nanorod InGaIn/GaN multiple quantum wells using nickel nano-masks and dry etching for InGaIn-based light-emitting diodes, *Material Science in Semiconductor Processing*, 2015, 30, 694-706.

[8] Wu Zhenlong, Chen Peng, Yang Guofeng\*, *et al.*, Morphology evolution and emission properties of InGaIn/GaN multiple quantum wells grown on GaN microfacets using crossover stripe patterns by selective area epitaxy, *Applied Surface Science*, 2015, 331, 444-448.

[9] Li Yuejing, Tong Yuying, Yang Guofeng\*, *et al.*, Selective area epitaxy of monolithic white-light InGaIn/GaN quantum well microstrips with dual color emission, *Journal of Vacuum Science & Technology A*, 2015, 33, 05E102.

[10] Yang Guofeng\*, Chen Peng, Liu Bin, *et al.*, Design of deep ultraviolet light-emitting diodes with staggered AlGaIn quantum wells, *Physica E*, 2014, 62, 55-58.

[11] Yang Guofeng\*, Li Guohua, Gao Shumei, *et al.*, Characteristics of N-face InGaIn light-emitting diodes with p-type InGaIn/GaN superlattice, *IEEE Photonics Technology Letter*, 2013, 25, 2369-2372.

[12] Yang Guofeng\*, Guo Ying, Zhu Huaxin, *et al.*, Fabrication of nanorod InGaIn/GaN multiple quantum wells with self-assembled Ni nano-island masks, *Applied Surface Science*, 2013, 285, 772-777.

#### 【科研获奖】

1. “图形化模板选择外延生长高效GaIn基LED及其自发白光技术”获2017年中国轻工业联合会科技进步奖，三等奖；
2. “基于图形化模板的高效GaIn基LED及其无荧光粉白光照明技术”获2017年中国商业联合会科技进步奖，三等奖；
3. “White-light emission from InGaIn/GaN quantum well microrings grown by selective area epitaxy”入选“2016中国光学重要进展”；
4. 2016年获“江苏省青年光学科技奖”；
5. 江南大学“至善学者”、“江南大学青年科研之星”和“至善责任学者”。

#### 【科研项目】

1. 国家自然科学基金青年基金，AlGaIn基深紫外雪崩光电二极管应力-位错-极化协同调控物理机制研究，2017/01-2019/12，主持，在研。
2. 国家自然科学基金理论物理专款，基于二硫化钨纳米带结构的电学性质理论研究，2016/01-2016/12，主持，在研。
3. 无锡市新兴产业技术研发项目，基于自组装镍纳米模板技术的GaIn基高效蓝光LED芯片研发，2016/07-2019/06，主持，在研。
3. 中央高校基本科研业务费重点专项项目，面向可见光通信和传感的新型半导体纳米结构光电器件研究，2016/01-2018/12，主持，在研。
4. 江苏省自然科学基金青年基金，用于气体监测的Si衬底纳米阵列GaIn肖特基传感器基础研究，2015/07-2018/06，主持，在研。
5. 中国博士后基金面上项目，Si衬底上复合极性微面多波长GaIn基LED的基础研究，2014/01-2015/12，主持，结题。
6. 企业横向课题，半导体低维纳米发光结构的技术开发，2014/01-2016/12，主持，结题。
7. 国家重点基础研究发展规划973项目，半导体固态照明用超高效率氮化物LED芯片基础研究，2011/01-2015/12，参与，结题。

#### 【在读硕、博士人数】

硕士8人

【以上资料更新日期】

2018年10月

分享到:

0



技术支持: 信息化建设与管理中心  
校内备案号: JW备170178

地址: 江苏省无锡市蠡湖大道1800号  
邮编: 214122  
联系电话: +86-510-85910532  
服务邮箱: cgq2098@jiangnan.edu.cn



微信服务号



微信订阅号



e江南APP